

図1 スキルミオンの模式図

矢印は電子スピンの向きを表す。スキルミオン中の電子スピンは渦巻き状に回りながら、中 心に向かっていく。中心と最外周のスピンの向きは上下反対になる。



## 図2電子顕微鏡観察用のマイクロ素子の模式図

らせん磁性体 FeGe(グレー)は、厚さ 100nm の薄膜部分から  $1 \mu m$ 、 $2 \mu m$ 、 $3 \mu m$ 



図3 ローレンツ電子顕微鏡によって観察した磁気構造

(a)ゼロ磁場のストライプ(らせん)構造。点線は結晶粒界を示す。

(b)デバイスに垂直に 150mT の磁場を印加して生成したスキルミオン結晶。

(c)スキルミオン結晶の拡大図。

(d)単一スキルミオン中の磁化分布。カラーと矢印はスキルミオン中の電子スピンの向きを示す。



## 図4スキルミオンの移動の様子と、並進運動するのに必要な電流密度の温度依存性

- (a) -23℃において、印加電流密度がゼロのときのローレンツ電子顕微鏡の像
- (b) -23℃において、印加電流密度が 26 A/cm<sup>2</sup>のときのローレンツ電子顕微鏡の像 スキルミオン結晶が右下へ移動し、点線より上側にはスキルミオン結晶が存在しない。
- (c) スキルミオン並進運動の臨界電流密度の温度依存性 温度の上昇とともに臨界電流密度は減少し、スキルミオン結晶が存在している-3℃で、 5A/cm<sup>2</sup>になる。黒、青、オレンジ色の線はそれぞれ異なる観察領域での測定データを示 す。